О возможности использования в разрезном микротроне постоянных поворотных магнитов с полями до 1T

А.И. Карев (ФИАН), В.Н. Мелехин (ИФП), Н.П. Собенин (МИФИ), В.В. Шведунов (НИИ ЯФ МГУ) Москва, Россия

Показана возможность создания постоянного поворотного магнита для разрезного микротрона на основе редкоземельных магнитных материалов. Обсуждается выбор оптималных параметров магнита и формирование торцевого магнитного поля.

Введение

Развитие технологии производства редкоземельных магнитных материалов (P3MM) и освоение их промышленного производства явились предпосылкой для внедрения постоянных магнитов в ускорительную технику. Разработаны различные дипольные и мультипольные магниты для оптики пучков и конструкции ондуляторов ЛСЭ, в которых используются P3MM [1]. В настоящей работе рассматривается возможность создания постоянных поворотных магнитов для разрезного микротрона.

Микротрон с P3MM магнитами имеет ряд преимуществ по сравнению с ускорителем с традиционными 180-градусными электромагнитами: в нем отсутствуют системы питания и охлаждения обмоток, что ведет к увеличению надежности всей установки и снижению энергопотребления, упрощает управление ускорителем и снижает трудоемкость его обслуживания, уменьшает суммарный вес установки и общий полезный объем, требуемый для ее размещения. Эти преимущества могут иметь важное значение особенно, если ускоритель проектируется как транспортабельный комплекс, например для работы в составе автономной мобильной системы обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков [2]. Кроме того, магнитные характеристики РЗММ позволяют формировать на краю поворотных магнитов специальную форму магнитного поля, в большей степени удовлетворяющую требованиям оптики пучка, чем это удается слелать в традиционных электромагнитах.

Основные характеристики РЗММ

(a) РЗММ характеризуются чрезвычайно высоким значением коэрцитивной силы H_c и удельной энергией (BH)^{max}. Типичные значения этих параметров для трех различных РЗММ привелены в табл.1. Здесь же для сравнения показаны магнитные параметры двух магнитных материалов, традиционно используемых для постоянных магнитов.

	H _c (kOe)	$B_r (kG)$	(BH) ^{max} (MGOe)
SmCo ₅	7,8 - 9,0	9,0-10,2	20 - 22
Sm_2Co_{17}	8,2 - 10,0	9,4 - 11,1	25 - 27
$Nd_2Fe_{14}B$	9,2 - 11,4	12,0 - 14,0	35 - 40
Альнико	0,5-1,6	5,5-11,6	2-4
Ферриты	0,2-0,3	2,0-3,5	1,0-3,5

Таблица 1. Магнитные характеристики магнито-твердых материалов.

(б) Кривая намагниченности РЗММ во втором квадранте на плоскости Н-В практически совпадает с прямой линий. В силу этого магнит полностью восстанавливает свой магнитный поток после воздействия внешнего размагничивающего поля и после процедуры сборки-разборки.

(в) РЗММ обладают выраженной анизотропией, и их свойства описываются как

$$\mathbf{B}_{\parallel} = \mathbf{B}_{\mathbf{r}} + \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{0}} \boldsymbol{\mu}_{\parallel} \mathbf{H}_{\parallel} \quad \mathbf{M} \quad \mathbf{B}_{\perp} = \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{0}} \boldsymbol{\mu}_{\perp} \mathbf{H}_{\perp},$$

где индексы характеризуют направление по отношению к так называемой "легкой оси"; значения μ_{\parallel} и μ_{\perp} близки к 1, это означает, что РЗММ не концентрирует в своем объеме внешний магнитный поток.

(г) Демонстрируя устойчивость к ионизирующему излучению и приемлемые вакуумные свойства, РЗММ обладают повышенной зависимостью магнитных характеристик от температуры. Хотя известны методы подавления этой зависимости, однако для коммерческих РЗММ температурные коэффициенты для B_r достигают 0,1 %/С° и для $H_c = 0,6$ %/С°.

Конфигурация магнитной цепи поворотного магнита

Существуют три основные конфигурации магнитной цепи для дипольного магнита С-типа, различающиеся положением РЗММ в железной арматуре магнита (рис.1). Генерация магнитного потока в рабочем зазоре Φ_g сопровождается возникновением паразитного потока $\Phi_p = \Phi_c + \Phi_a + \Phi_d$, где Φ_c , Φ_a и Φ_d — потоки между элементами магнита a-a, b-b и c-c. Величина паразитного магнитного потока тем больше, чем выше разность потенциалов между соответствующими частями магнита. Видно, что в случае "c" падение магнитного потенциала в арматуре магнита минимально, а для варианта "a" — максимально.



Рис.1. Конфигурации магнитной цепи дипольного магнита С-типа.

Этот вывод подтверждается результатами вычислений, выполненных по программе PANDIRA [3], откуда следует, что при прочих равных условиях величины индукции поля в зазоре Вg для конфигураций "a", "b" и "c" относятся как 0,5/0,75/1,0.

Выбор оптимальных параметров магнита

Обычно при разработке постоянных магнитов для минимизации необходимого количества магнитного материала рабочую точку стараются разместить вблизи точки (BH)^{max}. Можно показать, что для магнитов на основе P3MM это условие будет соответствовать слою P3MM на полюсах с суммарной толщиной h, равной высоте зазора g и значение Bg будет близко к m_0H_c /2 (~0,5 T). Однако для поворотного магнита разрезного микротрона условие минимизации объема P3MM (V) может не

соответствовать требованиям, предъявляемым к оптимальным параметрам магнита, поскольку значение B_g , кроме всего прочего, определяет размеры и вес магнита. Действительно, для ускорителя на заданную энергию увеличение B_g потребует увеличения толщины слоя P3MM, однако при этом площадь полюса будет уменьшаться, как ~1/Bg², и рост функции V(Bg) замедлится. Кроме того, увеличение B_g приведет к уменьшению магнитного потока в арматуре магнита и, если проектное значение максимальной индукции в железе останется неизменным, вес магнита P будет снижаться.

На рис.2 приведены зависимости относительного веса магнита P/P_0 и требуемого объема P3MM V/V₀ от значения индукции в рабочем зазоре, где P_0 — вес магнита при $B_g=1$ T, а V₀ соответствует объему P3MM при h=g. Из представленных кривых видно,



Рис.2. Зависимость P/P_0 и V/V_0 от B_g .

что для небольших микротронов на энергию 10-20 МэВ с относительно легкой и дешевой железной частью магнита оптимальное значение B_g лежит в диапазоне 0,6-0,8Т. Для ускорителей на энергию 50-100 МэВ границы приемлемых значений B_g следует сдвинуть в область больших значений, чтобы снизить вес, размеры и стоимость магнитов. По этой причине в проекте разрезного микротротрона на знергию 70 МэВ [5] было выбрано значение B_g =0,9 Т. При этом для одного магнита с h=2 см потребуется ~14,5 дм³ РЗММ.

Формирование поля у торца магнита

Для подавления вертикальной дефокусировки пучка, вызванной действием естественного расеянного поля, у края поворотного магнита можно сформировать участок с полем, имеющим обратную направленность [4]. При этом уменьшается эффективный диаметр первой орбиты $D_{\rm eff}$, что усугубляет трудности, связанные с обходом пучком ускоряющей структуры. Величина уменьшения $D_{\rm eff}$ зависит от расстояния между участком с обратным полем и границей области основного ведущего поля d. В обычных магнитах обратное поля формируется с помощью стальных полюсов и катушек, при этом расстояние d не может быть слишком малым, поскольку возникающий паразитный магнитный поток разрушает требуемую конфигурацию магнитного поля на краю магнита.



Рис.3. Конфигурация магнитной цепи на краю магнита. 1 — РЗММ с обратной намагниченностью, 2 — подвижный стальной элемент.

Для увеличения D_{eff} можно использовать уникальные магнитные свойства P3MM, позволяющие разместить магнитный материал с обратным направдением намагниченности вплотную к P3MM, формирующему основное ведущее поле (рис.3). Как следует из результатов компьютерного моделирования, замена электромагнита P3MM магнитом позволяет в разрезном микротроне на энергию 70 МэВ увеличить D_{eff} с 27 до 40 мм. Кроме того, предложенная конфигурация магнитной цепи обеспечивает необходимую точную настройку формы торцевого поля. Изменение величины воздушного зазора от 0 до 5 мм за счет перемещения стального элемента конструкции ведет к 15% уменьшению амплитуды противополя.

Заключение

Уникальные свойства редкоземельных магнитных материалов позволяют разработать постоянный магнит для разрезного микротрона с полем до 1 Т и сформировать торцевое поле с более высокими оптическими характеристиками, чем в электромагнитах.

Литература

- [1] Halbach K. J. Appl. Phys. 1985, v.57, pp.3605-3608.
- [2] Trower W.P., Karev A.I., Melekhin V.N., Shvedunov V.I., Sobenin N.P. Nucl. Instr&Meth. B99 (1995) 736-738
- [3] J.L.Warren, M.T.Menzel, G.Boicourt, H.Stokes, R.K.Cooper. Los Alamos National Laboratory, LA-UR-87-126, 1987.
- [4] Babic H., Sedlacek M. Nucl.Instr&Meth, v.56, (1967), 170-172.
- [5] Shvedunov V.I., Karev A.I., Melekhin V.N., Sobenin N.P. Trower W.P. Proc. of the 1995 Particle Accelerator Conference, May 1-5, 1995, Dallas, USA, v. 2, 1375-1377.